

	<h2>SIS407ADN-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIS407ADN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 18A 1212-8 PPAK</p> <p>Datenblätter:  SIS407ADN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2648 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIS407ADN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 18A 1212-8 PPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2648 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 15A, 4.5V
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 39.1W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SIS407ADN-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5875pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	168nC @ 8V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 18A (Tc) 3.7W (Ta), 39.1W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)

SIS407ADN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS407ADN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS407ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS407ADN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIS407DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 25A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SIS407ADN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SIS407ADN VISHAY VISHAY MSOP</p>	 <p>SIS4101PT1G SIS SIS4101PT1G SIS</p>
 <p>SIS407DN VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p>SIS407ADN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 18A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SIS406DN-T1-GE3-S VISHAY SIS406DN-T1-GE3-S VISHAY</p>	 <p>SIS410DN VB SIS410DN VB</p>

SIS407ADN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SIS407ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS407ADN-T1-GE3 Datenblatt	SIS407ADN-T1-GE3-Datenblätter	SIS407ADN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS407ADN-T1-GE3
SIS407ADN-T1-GE3 Electronic	SIS407ADN-T1-GE3-Komponenten	SIS407ADN-T1-GE3-Verteiler	SIS407ADN-T1-GE3-Bild	SIS407ADN-T1-GE3-Teil
SIS407ADN-T1-GE3 Preis	SIS407ADN-T1-GE3 Hersteller	SIS407ADN-T1-GE3 Bild	SIS407ADN-T1-GE3 Aktie	SIS407ADN-T1-GE3 Inventar
SIS407ADN-T1-GE3 Neu	SIS407ADN-T1-GE3 Original	SIS407ADN-T1-GE3 garantiert	SIS407ADN-T1-GE3 RFQ	SIS407ADN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited